# Министерство науки и высшего образования Российской Федерации НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ТОМСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (НИ ТГУ)

Физический факультет

УТВЕРЖДЕНО: Декан физического факультета С.Н. Филимонов

Рабочая программа дисциплины

# Физика низкоразмерных структур

по направлению подготовки

03.04.02 – Физика

Направленность (профиль) подготовки: «Фундаментальная и прикладная физика»

Форма обучения **Очная** 

Квалификация **Магистр** 

Год приема **2024** 

СОГЛАСОВАНО: Руководитель ОП О.Н. Чайковская

Председатель УМК О.М. Сюсина

#### 1. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины (модуля)

Целью освоения дисциплины является формирование следующих компетенций:

ПК-1 Способен самостоятельно ставить конкретные задачи научных исследований в области физики и решать их с помощью современной аппаратуры и информационных технологий с использованием новейшего российского и зарубежного опыта

Результатами освоения дисциплины являются следующие индикаторы достижения компетенций:

ИПК-1.1. Знает основные стратегии исследований в выбранной области физики, критерии эффективности, ограничения применимости

ИПК-1.2. Умеет выделять и систематизировать основные цели исследований в выбранной области физики, извлекать информацию из различных источников, включая периодическую печать и электронные коммуникации, представлять её в понятном виде и эффективно использовать.

#### 2. Задачи освоения дисциплины

Получить представления о теоретических методах исследования, физических свойствах и практическом использовании наноразмерных полупроводниковых структур.

# 3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы

Дисциплина относится к Блоку 1 «Физика полупроводников. Микроэлектроника». Дисциплина относится к части образовательной программы, формируемой участниками образовательных отношений, предлагается обучающимся на выбор.

## 4. Семестр(ы) освоения и форма(ы) промежуточной аттестации по дисциплине

Первый семестр, зачет.

#### 5. Входные требования для освоения дисциплины

Для успешного освоения дисциплины необходимо знание основ квантовой механики, физики твердого тела, термодинамики и статистической физики.

## 6. Язык реализации

Русский

#### 7. Объем дисциплины (модуля)

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 з.е., 28 часов, из которых:

- лекции: 14 ч.;
- практические занятия: 14 ч.;

Объем самостоятельной работы студента определен учебным планом.

#### 8. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам

Тема 1. Электронные состояния в низкоразмерных структурах

Условия наблюдения квантово-размерных эффектов. Потенциал Кроннига-Пенни. Минизоны в сверхрешетках. Классификация сверхрешеток. Типы сверхрешеток. Композитные, модулированные сверхрешетки. Модели разрывов зон и барьера Шоттки.

Комплексная зонная структура. Методы расчета. Комплексная зонная структура алмазоподобных соединений, зависимость от гетерограницы. Электронные состояния в квантовых ямах, проволоках, точках. Примесные состояния мелких центров в квантовых ямах. Энергетический спектр электронов в низкоразмерных структурах в присутствии постоянного магнитного поля.

Тема 2. Физические свойства сверхрешеток.

Продольный и поперечный транспорт. ОДП в сверхрешетках. Влияние колебаний решетки, примесей и несовершенств гетерограницы на свойства гетероструктур.

Тема 3. Квантовый эффект Холла.

Феноменологические результаты. Условия наблюдения. Целочисленный эффект Холла, одноэлектронная теория, влияние беспорядка. Роль многоэлектронных корреляций в нецелочисленном эффекте Холла.

Тема 4. Резонансное туннелирование электронов в гетероструктурах.

Туннелирование электронов через одну границу, один барьер, двухбарьерную структуру. Условия возникновения резонансных пиков. Резонансно-туннельный диод. Методы матрицы перехода и рассеяния, их свойства. Формула Брейта-Вигнера. Модели сшивания волновых функций на границах. Квазистационарные состояния. Открытая квантовая яма, времена жизни резонансов, полуширина пика. Эффекты междолинного смешивания электронных состояний на гетерогранице.

# 9. Текущий контроль по дисциплине

Текущий контроль по дисциплине проводится путем контроля посещаемости, тестов по лекционному материалу, выполнения домашних заданий и фиксируется в форме контрольной точки не менее одного раза в семестр. Оценочные материалы текущего контроля размещены на сайте ТГУ в разделе «Информация об образовательной программе» – <a href="https://www.tsu.ru/sveden/education/eduop/">https://www.tsu.ru/sveden/education/eduop/</a>

#### 10. Порядок проведения и критерии оценивания аттестации

Зачет проводится в устной форме по билетам, содержащим вопросы по курсу, предполагающие развернутый ответ и проверяющие ПК-1 и ИПК-1.2., а также по контрольным вопросам по материалу курса, требующим краткий ответ и проверяющим ИПК-1.1. Оценочные материалы текущего контроля размещены на сайте ТГУ в разделе «Информация об образовательной программе» – <a href="https://www.tsu.ru/sveden/education/eduop/">https://www.tsu.ru/sveden/education/eduop/</a>

#### 11. Учебно-методическое обеспечение

- a) Электронный учебный курс по дисциплине в электронном университете «Moodle» https://moodle.tsu.ru/course/view.php?id=22922
- б) Оценочные материалы текущего контроля и промежуточной аттестации по дисциплине.

# 12. Перечень учебной литературы и ресурсов сети Интернет

- а) основная литература:
- 1. Херман М. Полупроводниковые сверхрешетки. М.: Мир, 1989. 240 с.
- 2. Бехштедт Ф., Эндерлайн Р. Поверхности и границы раздела полупроводников. М.: Мир, 1990. 488 с.
- 3. Кульбачинский В.А. Двумерные, одномерные, нульмерные структуры и сверхрешетки. М.: Издательство физического ф-та МГУ, 1998. 162 с.

- 4. Воробьев Л.Е., Данило С.Н., Зегря Г.Г., Фирсов Д.А., Шалыгин В.А., Яссиевич И.Н., Берегулин Е.В. Фотоэлектрические явления в полупроводниках и размерно-квантованных структурах. Санкт-Петербург: Наука, 2001. 250 с.
- 5. Шик А.Я., Бакуева Л.Г., Мусихин С.Ф., Рыков С.А. Физика низкоразмерных систем. Санкт-Петербург: Наука, 2001. 160 с.
- 6. Ю П., Кардона М. Основы физики полупроводников. М.: Физматлит, 2002. 560 с.
- 7. Гридчин В.А., Неизвестный И.Г., Шумский В.Н. Физика микросистем. Новосибирск: Изд-во НГТУ, 2006. 496 с.
- 8. Кульбачинский В.А. Физика наносистем. М.: Физмалит, 2022. 768 с.
  - б) дополнительная литература:
- 1. Тернов И.М., Жуковский В.Ч., Борисов А.В. Квантовая механика и макроскопические эффекты. М.: Изд-во МГУ, 1993. –
- 2. Рашба Э.И., Тимофеев Б.Б. Квантовый эффект Холла. ФТП, т.20, N6, с.977–1024, 1986.
- 3. Шретер Ю.Г., Ребане Ю.Т., Зыков В.А., Сидоров В.Г. Широкозонные полупроводники. Санкт-Петербург: Наука, 2001. 125 с.

## 13. Перечень информационных технологий

- а) лицензионное и свободно распространяемое программное обеспечение:
- Microsoft Office Standart 2013 Russian: пакет программ. Включает приложения: MS Office Word, MS Office Excel, MS Office PowerPoint, MS Office On-eNote, MS Office Publisher, MS Outlook, MS Office Web Apps (Word Excel MS PowerPoint Outlook);
  - публично доступные облачные технологии (Google Docs, Яндекс диск и т.п.).
  - б) информационные справочные системы:
- Электронный каталог Научной библиотеки ТГУ <a href="http://chamo.lib.tsu.ru/search/query?locale=ru&theme=system">http://chamo.lib.tsu.ru/search/query?locale=ru&theme=system</a>
- Электронная библиотека (репозиторий) ТГУ <a href="http://vital.lib.tsu.ru/vital/access/manager/Index">http://vital.lib.tsu.ru/vital/access/manager/Index</a>
  - ЭБС Лань http://e.lanbook.com/
  - ЭБС Консультант студента <a href="http://www.studentlibrary.ru/">http://www.studentlibrary.ru/</a>
  - Образовательная платформа Юрайт https://urait.ru/
  - ЭБС ZNANIUM.com https://znanium.com/
  - ЭБС IPRbooks <a href="http://www.iprbookshop.ru/">http://www.iprbookshop.ru/</a>

#### 14. Материально-техническое обеспечение

Аудитории для проведения занятий лекционного типа.

Аудитории для проведения занятий семинарского типа, индивидуальных и групповых консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации.

Помещения для самостоятельной работы, оснащенные компьютерной техникой и доступом к сети Интернет, в электронную информационно-образовательную среду и к информационным справочным системам.

## 15. Информация о разработчиках

Гриняев Сергей Николаевич, доктор физ.-мат. наук, ТГУ, кафедра физики полупроводников, доцент.